

Title (en)

Connection device for power semiconductor device with a sealed connector

Title (de)

Verbindungseinrichtung für Leistungshalbleitereinrichtung mit dichtem Steckverbinder

Title (fr)

Dispositif de liaison pour un dispositif à semi-conducteurs de puissance avec connecteur étanche

Publication

EP 2688151 A1 20140122 (DE)

Application

EP 13168153 A 20130517

Priority

DE 102012212430 A 20120716

Abstract (en)

The assembly (10) has a connector having leads (31) connected to a contact unit (32) provided with a positioning device (321) and a sealing plastic housing (40). The sealing plastic housing is integrally formed with two mutually corresponding joinable structure (41), for sealing of the connection unit to a respective recess in the housing of the power semiconductor device. A first plate (410) and a second plate are arranged on the joinable structure. A recess is used for receiving the leads and contact unit. An independent claim is included for a method for forming connection with link assembly.

Abstract (de)

Verbindungseinrichtung (10) für eine ein Gehäuse (20) aufweisende Leistungshalbleitereinrichtung (1), wobei die Verbindungseinrichtung (10) einen Steckverbinder (30) mit Zuleitungen (31) mit angeschlossenen Kontakteinrichtungen (32) und einem Dichtstoffformkörper (40) aufweist, wobei die Kontakteinrichtungen (32) mit einer Positioniereinrichtung (321) ausgebildet sind, und wobei der Dichtstoffformkörper (40) einstückig mit zwei zueinander korrespondierenden zusammenfügbaren Teilkörpern (41) ausgebildet ist, zur Abdichtung der Verbindungseinrichtung (10) gegenüber einer zugeordneten zweiten Ausnehmung (21) im Gehäuse (20) der Leistungshalbleitereinrichtung (1) an seiner Außenseite erste Lamellen (410) aufweist, an der jeweiligen Innenseite der Teilkörper (41) angeordnete zweite Lamellen (420) aufweist, wobei die zweiten Lamellen (420) der Teilkörper (41) ineinandergreifend angeordnet sind und erste Ausnehmungen (430) zur Aufnahme der Zuleitungen (31) und der Kontakteinrichtungen (32) aufweist.

IPC 8 full level

H01R 13/50 (2006.01); **H01R 13/52** (2006.01); **H01R 4/70** (2006.01); **H01R 13/42** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 13/501 (2013.01); **H01R 13/5208** (2013.01); **H01R 13/521** (2013.01); **H01R 13/42** (2013.01)

Citation (applicant)

WO 2006054574 A1 20060526 - AUTONETWORKS TECHNOLOGIES LTD [JP], et al

Citation (search report)

- [XY] US 2009124123 A1 20090514 - TAKAHASHI SHINJI [JP]
- [YA] EP 2418744 A1 20120215 - TYCO ELECTRONICS SHANGHAI CO LTD [CN]
- [A] EP 2144336 A1 20100113 - INARCA SPA [IT]
- [A] JP H0992385 A 19970404 - SUMITOMO WIRING SYSTEMS
- [A] US 2008113543 A1 20080515 - TSUJI TAKESHI [JP], et al & WO 2006054574 A1 20060526 - AUTONETWORKS TECHNOLOGIES LTD [JP], et al

Cited by

EP3057183A1; WO2015193762A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2688151 A1 20140122; CN 103545654 A 20140129; CN 203521749 U 20140402; DE 102012212430 A1 20140220; DE 102012212430 B4 20170803

DOCDB simple family (application)

EP 13168153 A 20130517; CN 201310297999 A 20130716; CN 201320423136 U 20130716; DE 102012212430 A 20120716